

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{je} h _{jb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(rea)} * (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{je} *	h _{ie} *
2SC1271	日 電	RF	Si. E	20	3	30	250	200	0.05	8	100	8	10	8	-10					6000*	C _{re} 0.4		190		
" 1272	"	"	"	20	3	100	1W	200	50nA	15	80	10	40	10	-40	G _{pe} = 4dB (f = 4GHz)				4000*	C _{rr} <2		190		
" 1273	"	"	"	20	3	100	1W (T _c =25°C)	175	50nA	15	80	10	40	10	-60	G _{pe} = 4dB (f = 4GHz)							190		
" 1274	"	SW	"	40	5	300	300	175	0.25	20	70	1	30	8	-10	t _{on} < 80nS, t _{off} < 86nS t _{sig} < 65nS				350*	2.5		49C		
" 1275	"	RF	"	30	3	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _p = 15dB NF = 3dB (f = 500MHz) (f = 500MHz, 3mA)				2000*	1.1		50C		
" 1276	"	RF. SW	"	40	5	100	200	125	0.1	30	120	1	10	10	-10	t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{sig} < 20nS				600*	3	60*	138		
" 1277	"	RF	"	60	5	500	250	125	0.5	30	140	2	100	10	-20					60*	20	30*	138		
" 1278	"	RF. SW	"	150	5	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	-10					150*	4.5	15	138		
" 1279	"	"	"	180	5	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	-10					150*	4.5	15	138		
" 1280	"	RF	シリコン Si. E	15	10	300	250	125	0.1	10	20,000	5	100	10	-10					180*	5	220*	138		
" 1281	沖	"	Si. P	20	5	20	300	175	0.1	15	200	1	10μA	5	-1					120*	2	60*	49C		
" 1282	"	"	"	70	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1					120*	2	60*	49C		
" 1283	"	"	"	110	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1					120*	2	60*	49C		
★ 1284	三 洋	Osc	Si. EP	30	3	50	200	125	0.1	20	25~200	6	1	6	-1					700*	C _{re} 0.92				
★ 1285	"	RF. AF	Si	40	5	100	200	125	1	35	200	6	1	6	-1	180	2000	0.8	12	140*	3	C _c f _{sig} 200pS	138		
" 1286																									
" 1287																									
" 1288	沖	RF. SW	Si. EP	7	3	60	200	175	0.5	6	50	1	20	4	-20	t _d < 600pS, t _f < 650pS t _{rr} < 650pS				4500*	1	50*	144		
" 1289																									
" 1290	沖	PA	Si. EP	40	3	200	750	175	0.5	20	70	10	100	10	-50					*	2	35*	84B		
" 1291																									
★ 1292	三 菱	PA. SW	Si. EMe	300	5	2.5A	80W (T _c =25°C)	150	200	300	25	10	500			t _r < 1.5μS, t _f < 3μS, t _{sig} < 2μS							102		
" 1293	三 洋	RF	Si. EP	25	3	50	300	125	1	20	15~120	6	1	6	-1					400*	C _{re} 1.3	C _c f _{sig} 25pS	138		
" 1294																									
" 1295	三 洋	PA	Si. TMe	1000	7	2A	40W (T _c =25°C)	150	100	100	3~13	5	1A			t _r < 1.3μS							102		
★ 1296	"	SW	Si. T	1300	6	5A	50W (T _c =25°C)	150	100	100	> 4	5	3.5A											102	
" 1297	日 電	PA	Si. E	50	4	3.5A	80W (T _c =25°C)	175	1mA	30	50	10	2A	10	-700	P _o = 26W (f = 175MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 10W)				190*	75		149		
" 1298	"	"	"	50	4	5A	80W (T _c =25°C)	175	2mA	30	50	10	3A	10	-1A	P _o = 37W (f = 175MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 10W)				130*	110		149		
" 1299	富士通	SW	Si. TMe	300	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	50	150	40	5	10A	5	-2A	t _{on} < 2.5μS, t _f < 2.5μS t _{sig} < 4μS				25*			191		
" 1300	"	"	"	500	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	50	150	25	5	15A	5	-2A	t _{on} < 4μS, t _f < 2.5μS t _{sig} < 4μS				20*			191		